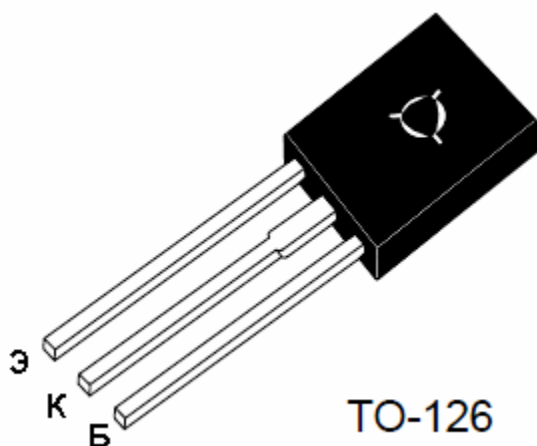


# 2SB772

## Кремниевый биполярный р-п-р транзистор.

Предназначен для использования в усилителях мощности, частоты и могут работать в ключевом режиме на низких частотах.



Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды = 25 °С.

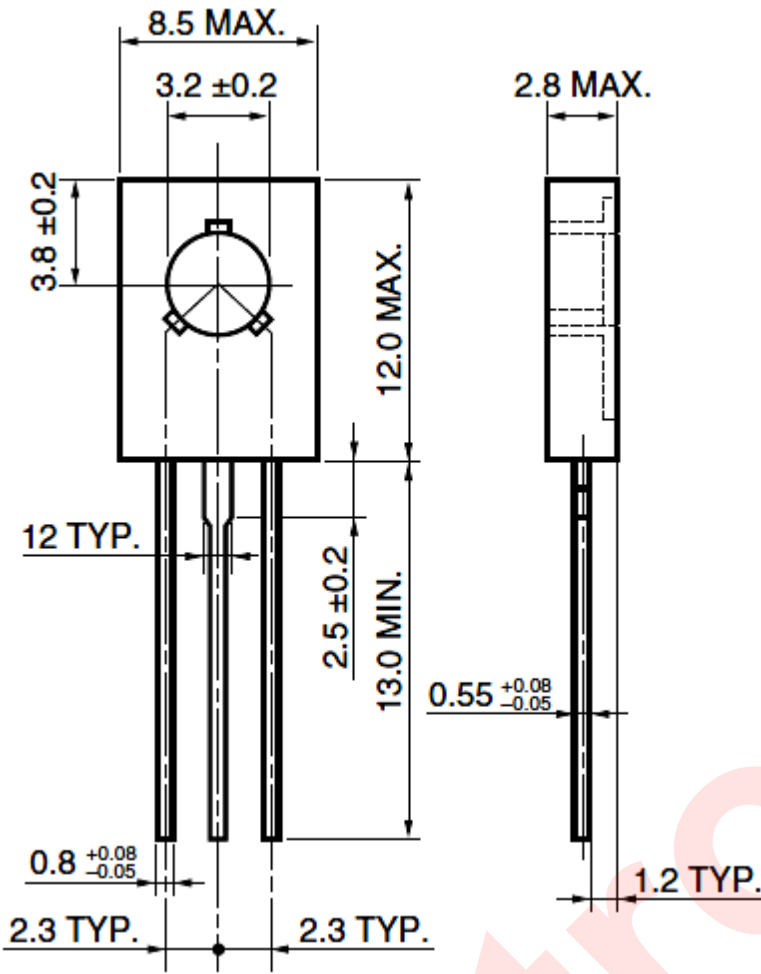
Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Uкб max	Напряжение коллектор-база	-40	В
Uкэ max	Напряжение коллектор-эмиттер	-30	В
Uэб max	Напряжение эмиттер-база	-5	В
Iк max	Постоянный ток коллектора	-3	А
Iк пик	Пиковый ток коллектора	-7	А
Pк max	Рассеиваемая мощность коллектора T <sub>A</sub> =25°С T <sub>C</sub> =25°С	1.0	Вт
		10	
T <sub>j</sub>	Температура перехода	150	°С
Tstg	Температура хранения	-55 до 150	°С

Электрические характеристики при Токр. среды = 25 °С.

Обозначение	Параметр	Условия испытания	Мин.	Тип.	Макс	Единицы измерения
h <sub>21э</sub>	Статический коэффициент передачи тока	I <sub>К</sub> =-20мА, Uкэ=-2.0В	30			
		I <sub>К</sub> =-1.0А, Uкэ=-2.0В				
		R	60		120	
		Q	100		200	
		P	160		320	
		E	200		400	
Uкэ(проб.)	Напряжение пробоя коллектор-эмиттер	I <sub>К</sub> =-1.0мА, I <sub>Б</sub> =0	-30			В
Uкб(проб.)	Напряжение пробоя коллектор-база	I <sub>К</sub> =-1.0мА, I <sub>Э</sub> =0	-40			В
Uэб(проб.)	Напряжение пробоя эмиттер-база	I <sub>Э</sub> =-1.0мА, I <sub>К</sub> =0	-5			В
Iкбо	Обратный ток коллектора	Uкб=-30В, I <sub>Э</sub> =0А			-1	мкА
Iэбо	Обратный ток эмиттера	Uэб=-3.0В, I <sub>К</sub> =0А			-1	мкА
Uкэ(нас)	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	I <sub>К</sub> =-2А, I <sub>Б</sub> =-200мА			-0.5	В
Uэб(нас)	Напряжение насыщения база-эмиттер	I <sub>К</sub> =-10мА, I <sub>Б</sub> =-200мА			-2.0	В
Свх.	Емкость коллектора (выходная)	Uкб=-10В, I <sub>Э</sub> =0, f=1МГц		55		пФ
fгр.	Граничная частота коэф. передачи тока	Uкэ=-5В, I <sub>К</sub> =-100мА, f=100МГц		80		МГц

# 2SB772

## ТО-126 МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Размеры в миллиметрах.

## Графики характеристик

